

# X 射线影像存储材料读写信号的关系 \*

赵 辉 王永生 徐 征 徐叙瑢

(北方交通大学光电子技术研究所 北京 100044)

**提要** 通过对光激励发光读出过程中各种电子转移过程的分析,建立了描述该过程的动力学方程组,通过求解在理论上得出了 X 射线影像存储材料中读写信号之间的线性关系。制备了 X 射线影像存储材料 BaFCl:Eu<sup>2+</sup>,通过光谱测试在实验上验证了这一关系。

**关键词** 光激励发光,X 射线,读出过程

## 1 引 言

基于光激励发光现象的 X 射线影像存储材料在医疗、无损检测、电镜照相等 X 射线检测领域获得了广泛的应用。光激励发光过程可简述如下:X 射线辐照使材料中产生大量的自由电子,它们可被陷阱俘获,完成存储过程。若陷阱足够深,这些信息可保存很长时间。读出时用长波光照射,电子受激励而离开陷阱到达发光中心复合发光,从而完成读出过程。在应用中,X 射线辐照剂量是写入信号,激励时的发光强度是读出信号。读写信号之间的关系是该领域的一个基本问题。本文从理论和实验两个方面,对该问题进行了研究。

## 2 理论分析

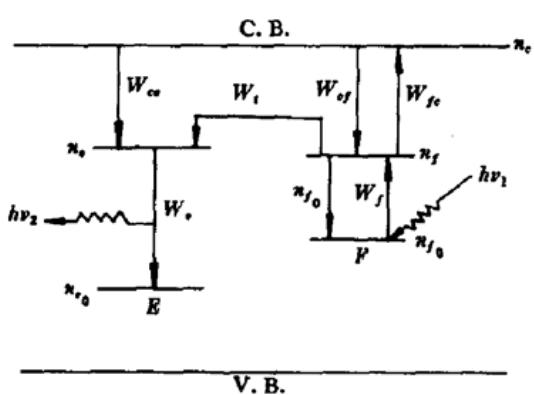


图 1 X 射线影像存储材料的读出过程

Fig. 1 Readout process of the X-ray image storage material

图 1 示出了 X 射线影像存储材料的能级情况和读出过程中电子转移的各种途径。其中 F 为材料中阴离子空位形成的 F 色心(电子陷阱),E 代表发光中心。 $n_{f_0}$ , $n_f$ , $n_c$ , $n_e$ , $n_{e_0}$  分别是 F 色心基态、激发态、导带、发光中心激发态、基态的电子布居数。X 射线辐照时,激发的电子被陷阱俘获,暂态过程结束后,材料中的电子分布状态可用下式表示<sup>[1]</sup>

$$\begin{cases} n_e = n_c = n_f = 0 \\ n_{f_0} = \gamma D \end{cases} \quad (1)$$

式中 D 为 X 射线辐照剂量,  $\gamma$  为比例因子。(1)式为读出过程的初始条件。

\* 国家自然科学基金资助项目。

读出时,读出光照射材料使色心基态电子跃迁至激发态,此时电子有三种可能:弛豫回色心基态;热激发至导带<sup>[2]</sup>;隧穿至发光中心复合发光<sup>[3]</sup>。读出过程中各种电子转移途径及其相应的概率如图 1 中所示。在以上分析的基础上,可列出描述读出过程的动力学方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dn_{f_0}}{dt} = n_f W_f - n_{f_0} W_{f_0} \\ \frac{dn_f}{dt} = n_{f_0} W_{f_0} + n_c W_{cf} - n_f W_{fc} - n_f W_f - n_f W_t \\ \frac{dn_c}{dt} = n_f W_{fc} - n_c W_{cf} - n_e W_{ce} \\ \frac{dn_e}{dt} = n_c W_{ce} + n_f W_t - n_e W_e \\ \frac{dn_{e_0}}{dt} = n_e W_e \end{array} \right. \quad (2)$$

取近似条件  $W_f n_f \ll W_{f_0} n_{f_0}$ , 我们求解了该方程组, 得出读出过程中发光强度为

$$I(t) \propto W_e n_e(t) = \frac{W_e \gamma_1 D}{W_{f_0}^2 - a_1 W_{f_0} + a_2} (E_1 e^{r_1 t} + E_2 e^{r_2 t} + E_3 e^{-W_{f_0} t} + E_4 e^{-W_0 t}) \quad (3)$$

式中

$$E_1 = \frac{W_{f_0} + r_2}{(W_e + r_1)(r_1 - r_2)} \left[ W_{ce} + \frac{W_t}{W_{fc}} (W_{cf} + W_{ce} + r_1) \right]$$

$$E_2 = \frac{W_{f_0} + r_1}{(W_e + r_2)(r_2 - r_1)} \left[ W_{ce} + \frac{W_t}{W_{fc}} (W_{cf} + W_{ce} + r_2) \right]$$

$$E_3 = \frac{1}{W_e - W_{f_0}} \left[ W_{ce} + \frac{W_t}{W_{fc}} (W_{cf} + W_{ce} - W_{f_0}) \right]$$

$$E_4 = -(E_1 + E_2 + E_3)$$

$$r_1 = \frac{1}{2}(-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2}) \quad r_2 = \frac{1}{2}(-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2})$$

$$a_1 = W_{cf} + W_{ce} + W_{fc} + W_f + W_t \quad a_2 = (W_{fc} + W_f + W_t)(W_{cf} + W_{ce}) - W_{fc} W_{cf}$$

$\gamma_1$  为比例因子。由此可见,  $I(t)$  与  $D$  之间存在严格的线性关系。

### 3 实验

#### 3.1 材料制备

将一定配比的  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{F}$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{Eu}_2\text{O}_3$  混合研磨, 在  $400^\circ\text{C}$  下烧结 1 h, 使其脱去结晶水。取出材料后冷却至室温, 重新研磨。将炉温升至  $760^\circ\text{C}$ , 再烧结 2 h, 同时通入( $\text{N}_2 + 5\% \text{H}_2$ ) 的气氛。反应方程式为



$\text{Eu}$  离子的掺杂浓度为 1%。制备的材料经 X 射线衍射分析, 确定为  $\text{PbFCl}$  型单一物相结构。

#### 3.2 光谱测试

利用日立 F-4010 型分光光度计, 测量了其激发光谱、发射光谱和光激励谱(读出时发光强度随激励波长的变化关系), 得出了其最佳发射波长为 386 nm, 读出时最佳激励波长为 450 nm 或 550 nm。在此基础上, 我们对读写信号的关系进行了测试, 测试系统如图 2 所示。首先打

开 X 光机,用 X 射线(10 mA, 35 kV)辐照样品一定时间,关闭 X 光机。打开激励单色仪,以 450 nm 的光激励样品,用接收单色仪监测样品在 386 nm 处的发光。改变 X 射线辐照的时间,保持其它条件不变,重复上述过程,即测得了光激励发光强度与 X 射线辐照时间(即辐照剂量)的关系,如图 3 所示。测量中在激励单色仪与样品之间放置了 350 nm 的滤波片,以防止激励单色仪二次谐波的光激发样品;每次辐照前都先将样品漂白,以避免上次辐照对本次实验的干扰。由图 3 可见,光激励发光强度与 X 射线辐照剂量在仪器所能测量的 5 个数量级内为线性关系。

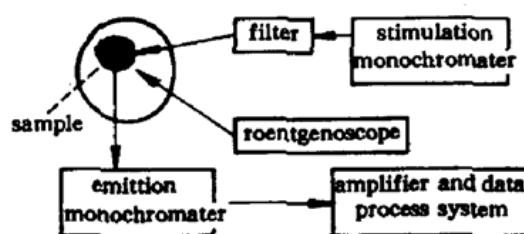


图 2 光谱测试系统图

Fig. 2 Schematic diagram of the spectral measurement system

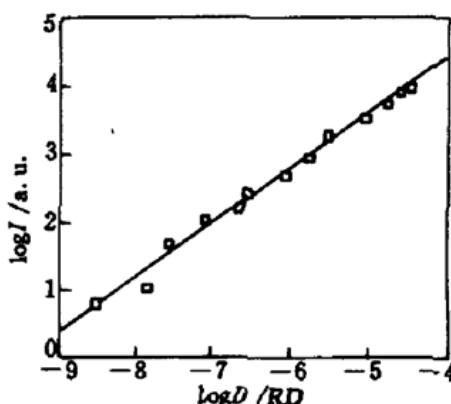


图 3 发光强度与 X 射线辐照剂量的关系

Fig. 3 The relationship between luminescence and X-ray irradiation dose

## 参 考 文 献

- 1 H. von Seggern, T. Voigt. Physical model of photostimulated luminescence of X-ray irradiated BaFBr:Eu<sup>2+</sup>. *J. Appl. Phys.*, 1988, 64(3) : 1405~1412
- 2 Kenji Takahashi, K. Kohda, J. Miyahara *et al.*. Mechanism of photostimulated luminescence in BaFX:Eu<sup>2+</sup>(X=Cl, Br) phosphors. *J. of Luminescence*, 1984, 31&32 : 266~268
- 3 D. W. de Leeuw, T. Kovats, S. P. Herko. Kinetics of photostimulated luminescence in BaFBr:Eu<sup>2+</sup>. *J. Electron Chem. Soc: Solid-state Science and Technology*, 1987, (2) : 491~496

## The Relationship between Readout and Write-in Signals in X-ray Image Storage Material

Zhao Hui Wang Yongsheng Xu Zheng Xu Xurong

(Institute of Optoelectronic Technology, Northern Jiaotong University, Beijing 100044)

**Abstract** The electron transfer process in photostimulated luminescence is studied and a set of equations are set up. The linear relationship between readout and write-in signals in X-ray image storage materials is obtained theoretically by solving these equations. This result is confirmed in the experiments of BaFCl:Eu<sup>2+</sup>.

**Key words** photostimulated luminescence, X-ray, readout